








	<p><b>SI3443DV</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3443DV</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI3443DV.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 82854 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DV
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	82854 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	Micro6™(TSOP-6)
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 4.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1079pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tube

SI3443DV ist neu im Original, Suche SI3443DV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DV International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443DV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3443DV-T1</b> VISHAY SI3443DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3443DV</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3443DV</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>
 <p><b>SI3443DL-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI3443DDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3443DDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>

heiße Teile

Mehr

SI3442BDV	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442BDV-T1-GE3
SI3442CDV-T1-GE3	SI3442CDV-T1-GE3	SI3442CDV	SI3442DV	SI3442DV-T1
SI3442DV-T1-E3	SI3442DV-T1-GE3	SI3443ADV-T1-E3	SI3443BDV	SI3443BDV-T1-E3
SI3443BDV-T1-E3	SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BVD	SI3443CDV-T1-E3
SI3443CDV-T1-E3	SI3443CDV-T1-GE3	SI3443CDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3
SI3443DV	SI3443DV	SI3443DV-NL	SI3443DV-T1	SI3443DV-T1-E3
SI3443DV-T1-GE3	SI3443DVTR	SI3443DVTRPBF	SI3445ADV-T1	SI3445ADV-T1-E3
SI3445ADV-T1-E3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445BDV	SI3445DV
SI3445DV-T1	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-GE3
SI3445DV-T1-GE3	SI3446ADV-T1	SI3446ADV-T1-E3	SI3446ADV-T1-E3	SI3446ADV-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited